



この翻訳版ドキュメントのメンテナンスは終了しております。

この文書には、古いコンテンツや商標が含まれている場合があります。

最新情報につきましては、次のリンクから英語版の最新資料をご確認ください。

<https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/lit-index.html>

Please take note that this document is no longer being maintained. It may contain legacy content and trademarks which may be outdated.

Please refer to English version for latest update at

<https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/lit-index.html>



# MAX II CPLD を使用した NAND フラッシュ・メモリ・インタフェース

この資料は英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。こちらの日本語版は参考用としてご利用ください。設計の際には、最新の英語版で内容をご確認ください。

2007 年 12 月 ver 1.0

Application Note 500

## はじめに

本書では、アルテラの MAX<sup>®</sup> II CPLD を使用した NAND フラッシュ・メモリ・インタフェースの実装について説明します。本デザインは、Samsung および AMD 両方の NAND フラッシュ・メモリで使用することができます。

## フラッシュ・メモリ

フラッシュ・メモリは、電氣的にプログラムおよび再プログラムが可能な不揮発性の半導体メモリです。情報はセル・アレイに格納されます。各セルには1ビットの情報を保持できます。セルは、MOSFET のコントロール・ゲートとシリコン・サブストレートの間に浮遊ゲートが存在するデュアル・ゲート構造になっています。二酸化シリコン絶縁体がこの浮遊ゲートを絶縁するために使用されています。これがフラッシュ・メモリ・デバイスの基本的なストレージ・メカニズムです。

NOR フラッシュと NAND フラッシュは、フラッシュ・メモリ・デバイスの2つのバリエーションです。NOR 型フラッシュ・メモリはランダム・アクセスが可能であり、NAND 型フラッシュ・メモリはシーケンシャル・アクセス・デバイスです。これら2つのフラッシュ・メモリのインタフェースは大きく異なります。NOR 型フラッシュ・メモリは、専用のアドレス・ラインおよびデータ・ラインを内蔵していますが、NAND 型メモリには専用アドレス・ラインがありません。

NOR 型と NAND 型を比較した場合、NAND 型にはセル面積の縮小に伴うビットあたりのコスト低減、集積度の向上、耐久性の向上、および消去時間とプログラミング時間の短縮など、大きな利点があります。これらの利点により、NAND フラッシュ・メモリは、USB フラッシュ・ドライブ、MP3 プレーヤ、デジタル・オーディオ・レコーディング、デジタル TAD (Telephone Answering Devices) のデータ・ストレージ、デジタル・カメラ、および CompactFlash および MemoryStick などのメモリ・カード製品に使用されています。

本書では、アルテラ MAX II CPLD への NAND フラッシュ・メモリ・インタフェースの実装について説明します。デザインは、Samsung および AMD 両方の NAND フラッシュ・メモリで使用することができます。この例では、AMD Am30LV0064D および Samsung K9F4008W0A フラッシュ・デバイスが使用されています。

AMD NAND フラッシュ・デバイス (Am30LV0064D) は、データがシーケンシャルで、高速書き込み機能が要求される高集積アプリケーションに最適な 64 M ビット・マス・ストレージ・デバイスです。最初のページのリード・アクセス時間は 7  $\mu$ s、以降のバイト・アクセス時間は 50 ns 未満になります。

Samsung NAND フラッシュ・デバイス (K9F4008W0A) は、高性能レベルや高集積度フラッシュ・メモリの大容量を必要としないアプリケーションに最適な 512 K × 8 ビットのストレージ・デバイスです。ランダム・アクセス時間 15  $\mu$ s、シーケンシャル・アクセス時間 120 ns の 32 バイト・フレーム・リード動作をサポートします。

## MAX II を 使用した NAND フラッシュ・ インタフェー ス

図 1 に、インタフェース・ブロック図を示します。システムからのコマンドは、NAND フラッシュ・インタフェースの入力にコード化された形で到達します。実行される各動作は、異なるフォーマットでコード化され、3 ビット幅のコントロール・バスを通じて発行されます (4 ページの表 2 を参照)。

表 1 に、インタフェースのピンの説明を示します。ALE、CLE、SE、WE の場合のイネーブルまたはディセーブルは、イネーブル / ディセーブル信号入力で個別に行われます。これらのコマンドは、NAND フラッシュ・インタフェース・ブロック (アルテラ MAX II CPLD) によって正しく符号化され、出力イネーブルまたはディセーブル信号として変換され、NAND フラッシュに必要な動作が実行されるようにします。

NAND フラッシュで実行される実際の動作は、I/O バスを介してコマンド・レジスタに書き込まれるコマンドによって制御されます (5 ページの表 3 および 6 ページの表 4 を参照)。読み書きされるデータのアドレスは、データと共に同じバスを介して発行されます。

図 1 は、NAND フラッシュ・デバイスの異なるインタフェース信号を示しています。'#' が付いた信号は Low のときにアサートされます。

図 1. NAND フラッシュ・デバイスのインタフェース信号

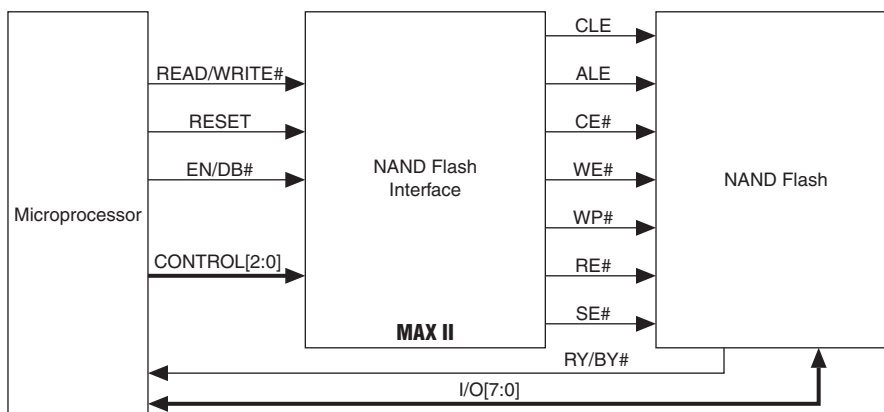


表 1 は、インタフェース信号を説明しています。

表 1. 図 1 のブロック図に記載されている信号の概要 (1 / 2)		
信号	サイズ	説明
READ/WRITE#	1 ビット	書き込み動作と読み出し動作を区別するためのマイクロプロセッサからの入力です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● READ/WRITE# 0: 書き込み動作</li> <li>● READ/WRITE# 1: 読み出し動作</li> </ul>
RESET	1 ビット	NAND フラッシュ・デバイスをリセットするためのマイクロプロセッサからの入力です。
CONTROL[2:0]	3 ビット	3 ビット・コントロール・バス。マイクロプロセッサが NAND フラッシュ・インタフェース (アルテラ MAX II) に 3 ビットの情報を送信すると、そこで適切に符号化され、EN/DB# 入力の状態に応じて適切なインタフェース信号がイネーブルまたはディセーブルされます。
EN/DB#	1 ビット	必要な動作を実行するために他のコントロール・ビットとともに使用されるコントロール・ビットです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● EN/DB# 1: コントロール・ビットで選択されたインタフェース信号をイネーブルします。</li> <li>● EN/DB# 0: コントロール・ビットで選択されたインタフェース信号をディセーブルします。</li> </ul>
I/O[7:0]	8 ビット	データ / コマンド / アドレスを NAND フラッシュ・デバイス内の対応するレジスタに送信するのに使用される双方向 8 ビット多重化バスです。これらのラインでは NAND フラッシュ・デバイスから読み出されるデータも利用可能です。
RY/BY#	1 ビット	デバイスの状態を示す NAND フラッシュ・デバイスからの出力です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● RY/BY# 0: デバイスは動作を実行中でビジーの状態です。</li> <li>● RY/BY# 1: デバイスは次のコマンドを受け入れ可能な状態です。</li> </ul>
CLE	1 ビット	アクティブ High のコマンド・ラッチ・イネーブル。デバイスのコマンド・レジスタまたはデータ・レジスタを選択するのに使用します。High のとき、I/O ライン上のコマンドは WE# の立ち上がりエッジでコマンド・レジスタにラッチされます。(1)
ALE	1 ビット	アクティブ High のアドレス・ラッチ・イネーブル。デバイスのアドレス・レジスタまたはデータ・レジスタを選択するのに使用します。High のとき、I/O ライン上のアドレスは WE# の立ち上がりエッジでアドレス・レジスタにラッチされます。Low 信号は、デバイスのリセットを引き起こします。この信号は、アドレス・シーケンス中には High にしておく必要があります。(1)
CE#	1 ビット	アクティブ Low のチップ・イネーブル。デバイスのアクティブ・モードとスタンバイ・モードのいずれかを選択するのに使用します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● CE# 0: アクティブ・モードが選択されます。</li> <li>● CE# 1: 現在動作が実行中でない場合は、スタンバイ・モードが選択されます。</li> </ul> <p>プログラムまたは消去動作が実行中の場合、CE 信号は無視されます。</p>

表 1. 図 1 のブロック図に記載されている信号の概要 (2 / 2)

信号	サイズ	説明
WE#	1 ビット	アクティブ Low のライト・イネーブル。コマンド / アドレス / データをデバイス内の対応するレジスタに書き込むのに使用します。I/O ライン上の情報は、WE# の立ち上がりエッジで対応するレジスタにラッチされます。
WP#	1 ビット	アクティブ Low の書き込み保護。 WP# 0 : デバイスは書き込み保護されています。 WP# 1 : デバイスは書き込み保護されていません。
RE#	1 ビット	アクティブ Low のリード・イネーブル。デバイスからデータ / ステータスを読み出すのに使用します。この情報は、I/O ライン上において RE# の立ち上がりエッジで使用できます。
SE#	1 ビット	アクティブ Low の Spare 領域のイネーブル。AMD デバイスが使用されているときにのみ必要です。Samsung デバイスには必要ありません。 ● SE# 0 : 各ページの 16 バイトの Spare 領域がイネーブルされます。 ● SE# 1 : Spare 領域はディセーブルされます。

## 表 1 の注:

- (1) データ・レジスタは、CLE と ALE の両方を Low にすることにより選択されます。I/O ライン上のデータは、WE# の立ち上がりエッジでデータ・レジスタにラッチされます。

表 2. コントロール信号の異なる組み合わせでインタフェースが実行する動作 (1 / 2)

コントロール信号 [2:0]	EN/DB#	実行される動作
000	—	EN/DB# の状態に関係なく、コマンド・ラッチ・イネーブルはイネーブルされず (CLE = 1)。
001	—	I/O ライン上で送信されたコマンドに応じて、データ / ステータス / デバイス ID を読み出します。
010	—	I/O ライン上で送信されたコマンドに応じて、データ / コマンド / アドレスを書き込みます。
011	1 0	ALE がアサートされます (High)。 ALE がディセーブルされます (Low)。
100	1 0	SE# がアサートされます (Low)。 SE# がディセーブルされます (High)。(1)
101	1 0	WP# がアサートされます (Low)。 WP# がディセーブルされます (High)。
110	1 0	CE# がアサートされます (Low)。 CE# がディセーブルされます (High)。

表 2. コントロール信号の異なる組み合わせでインタフェースが実行する動作 (2 / 2)

コントロール信号 [2:0]	EN/DB#	実行される動作
111	1 0	フラッシュ・デバイスの状態が RY/BY# ライン上で送信されます。 RY/BY# ラインにはフラッシュ・デバイスの状態は反映されません。

表 2 の注:

- (1) この動作は、AMD フラッシュ・デバイスにのみ適用されます。このコマンドは、EN/DB# ラインの条件に応じて、各ページの 16 バイトのスペア領域をイネーブル / ディセーブルすることができます。

表 3 および 4 に、AMD NAND フラッシュ・デバイス (Am30LV0064D) および Samsung NAND フラッシュ・デバイス (K9F4008W0A) でサポートされている各種コマンドの情報を示します。

表 3. Am30LV0064D コマンド・セット

動作	サイクル 1	サイクル 2	ビジー時の有効性
データの読み出し	00h/01h	—	無効
ギャップレス読み出し (1)	02h	—	無効
予備領域の読み出し	50h	—	無効
ID の読み出し	90h	—	無効
ステータスの読み出し	70h	—	有効
データの入力 (2)	80h	—	無効
ページ・プログラム (2)	10h	—	無効
ブロック消去 (3)	60h	D0h	無効
消去中断 (1)	B0h	—	有効
消去再開 (1)	D0h	—	無効
リセット	FFh	—	有効

表 3 の注:

- AMD NAND フラッシュ・デバイスでのみサポートされるスーパーセット・コマンドです。
- フラッシュ・アレイへのデータのプログラミングは 2 つのステップで構成されており、2 つの別々のコマンド・シーケンスを実行する必要があります。プログラムするデータは、入力データ・コマンド・シーケンスを使用してデータ・レジスタにロードしなければなりません。データをロードした後、Page Program コマンドが実行され、データ・レジスタからフラッシュ・アレイに情報が転送されます。
- ブロック消去も 2 つのコマンドから成るプロシージャです。最初のコマンド・サイクルで、消去されるブロックのアドレスがデバイスに発行されます。次のコマンド・サイクルで、WE# 信号の立ち上がりエッジを検出するとフラッシュ・デバイスは消去動作を開始します。

フラッシュ・デバイスのプログラミングは、ページ単位（512 バイト + 16 バイトの予備領域）で行われますが、消去はブロック単位で行われます（8 K バイト + 256 バイト）。

消去中断および消去再開は、スピードが重視されるタスクを実行するために用意されています。これらのタスクはまだ消去されていないブロックでのみ実行できます。ギャップレス読み出しは、特別な高性能モードでデータを読み出すのに使用されます。これにより、最初のページ転送で、わずか 7  $\mu$ s のレイテンシで複数のページを読み出すことができます。



AMD NAND フラッシュ・デバイスの詳細情報は、[www.spansion.com/datasheets/22203c4.pdf](http://www.spansion.com/datasheets/22203c4.pdf) を参照してください。

動作	サイクル 1	サイクル 2	ビジー時の有効性
読み出しデータ	00h	—	無効
ID の読み出し	90h	—	無効
ステータスの読み出し	70h	—	有効
フレーム・プログラム (1)	80h	10h	無効
ブロック消去 (2)	60h	D0h	無効
リセット	FFh	—	有効

表 4 の注：

- (1) フレーム・プログラムは、2 つのコマンドから成るプロシージャです。Frame Program セットアップ・コマンド (80h) でプログラムするデータのロードを開始します。Frame Program 確認コマンド (10h) でプログラミング・プロセスが開始されます。
- (2) ブロック消去も 2 つのコマンドから成るプロシージャです。Erase セットアップ・コマンド (60h) で消去するブロックのアドレスがロードされます。Erase 確認コマンド (D0h) がロードされると、フラッシュ・デバイスは内部消去プロセスを開始します。

フラッシュ・デバイスのプログラミングはフレーム単位（32 バイト）で実行されますが、消去はブロック単位（4 K バイト）で実行されます。フラッシュ・デバイスは、部分フレーム・プログラミングもサポートしています。



Samsung NAND FLASH デバイスの詳細情報は、[www.datasheet4u.com/html/K/9/F/K9F4008W0A\\_Samsungsemiconductor.pdf.html](http://www.datasheet4u.com/html/K/9/F/K9F4008W0A_Samsungsemiconductor.pdf.html) を参照してください。

## 実装

本デザインは、EPM240 またはその他の MAX II CPLD を使用して実装できます。デザインのソース・コードはコンパイルして、MAX II CPLD にプログラムすることができます。ホスト・インタフェース・ポートおよび NAND フラッシュ・デバイスは、2 ページの図 1 に示されています。図に示す NAND フラッシュ・インタフェース・デザインは、AMD NAND フラッシュ・デバイス Am30LV0064D および Samsung NAND フラッシュ・デバイス K9F4008W0A に対応しています。

## ソース・コード

このデザイン例は Verilog HDL で記述されています。ソース・コード、テストベンチ、および完成した Quartus II プロジェクトは、以下から入手可能です。

[www.altera.co.jp/literature/an/an500\\_design\\_example.zip](http://www.altera.co.jp/literature/an/an500_design_example.zip)

## まとめ

このデザイン例が示すように、MAX II CPLD は NAND フラッシュなどのメモリ・デバイスへのインタフェースを実装する際に有力な選択肢となります。MAX II CPLD は、低消費電力で使いやすいパワー・オン機能を備えており、このようなメモリ・デバイス・インタフェース・アプリケーションに最適なプログラマブル・ロジック・デバイスです。

## 関連情報

以下に、関連資料を示します。

- MAX II CPLD ホームページ：  
[www.altera.co.jp/products/devices/cpld/max2/mx2-index.jsp](http://www.altera.co.jp/products/devices/cpld/max2/mx2-index.jsp)
- MAX II デバイスの資料ページ：  
[www.altera.co.jp/literature/lit-max2.jsp](http://www.altera.co.jp/literature/lit-max2.jsp)
- MAX II パワーダウン・デザイン：  
[www.altera.co.jp/support/examples/max/exm-power-down.html](http://www.altera.co.jp/support/examples/max/exm-power-down.html)
- MAX II アプリケーション・ノート：  
[AN 428: MAX II CPLD のデザイン・ガイドライン](#)  
[AN 422: MAX II CPLD を使用したポータブル・システムにおける消費電力の管理](#)



## 改訂履歴

表 5 に、このアプリケーション・ノートの改訂履歴を示します。

表 5. 改訂履歴		
日付 & バージョン	変更内容	注記
2007 年 12 月 v1.0	初版	—



101 Innovation Drive  
San Jose, CA 95134  
www.altera.com  
Literature Services:  
literature@altera.com

Copyright © 2007 Altera Corporation. All rights reserved. Altera, The Programmable Solutions Company, the stylized Altera logo, specific device designations, and all other words and logos that are identified as trademarks and/or service marks are, unless noted otherwise, the trademarks and service marks of Altera Corporation in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of their respective holders. Altera products are protected under numerous U.S. and foreign patents and pending applications, maskwork rights, and copyrights. Altera warrants performance of its semiconductor products to current specifications in accordance with Altera's standard warranty, but reserves the right to make changes to any products and services at any time without notice. Altera assumes no responsibility or liability arising out of the application or use of any information, product, or service described herein except as expressly agreed to in writing by Altera Corporation. Altera customers are advised to obtain the latest version of device specifications before relying on any published information and before placing orders for products or services.

